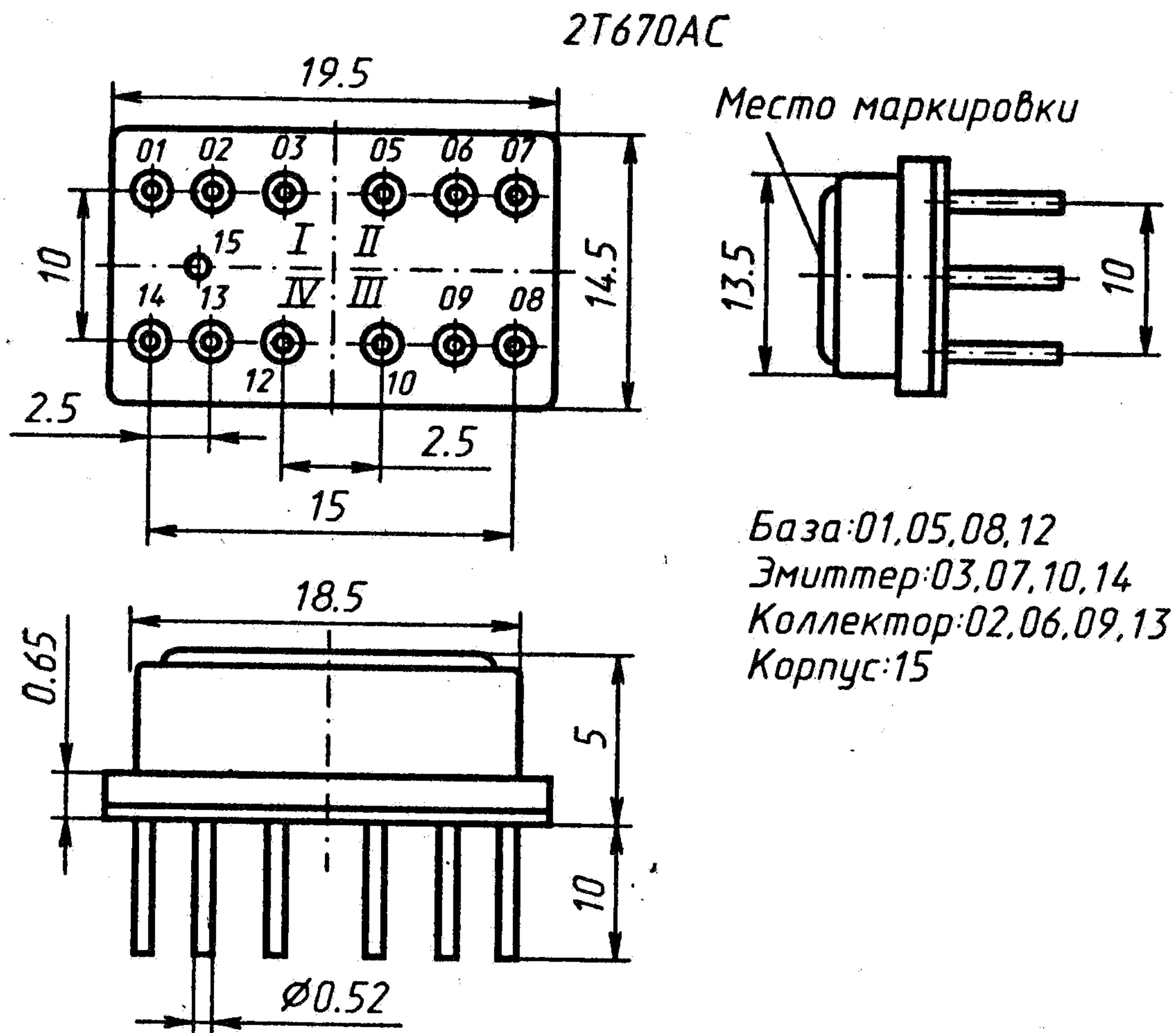


2Т670АС

Сборка из четырех кремниевых эпитаксиально-планарных структуры *n-p-n* диэлектрически изолированных и электрически развязанных транзисторов. Предназначена для применения в импульсных и переключательных устройствах. Выпускается в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Масса сборки не более 3,5 г. Изготовитель — завод «Транзистор», г. Минск.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 200$ мА:

$T = +25$ °С	40...200
$T = +125$ °С	30...300
$T = -60$ °С	20...200

Граничная частота коэффициента передачи тока

при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_К = 30$ мА, не менее 200 МГц

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер

при $I_К = 400$ мА, $I_Б = 80$ мА, не более 1 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 400$ мА, $I_B = 80$ мА, не более	2 В
Постоянное прямое напряжение в диодном включении при $I_3 = 500$ мА, не более	1,2 В
Время рассасывания $I_K = 150$ мА, $I_{B1} = I_{B2} = 15$ мА, не более	100 нс
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, не более	15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$, не более	50 пФ
Обратный ток коллектора, не более:	
$T = +25$ °С и -60 °С, при $U_{КБ} = 50$ В	5 мкА
$T = +125$ °С, при $U_{КБ} = 35$ В	50 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 4$ В, не более	5 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:	
при $T_{п} = -60...+100$ °С	50 В
при $T_{п} = +125$ °С	35 В
при $T_{п} = +150$ °С	20 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 0$:	
при $T_{п} = -60...+100$ °С	50 В
при $T_{п} = +125$ °С	35 В
при $T_{п} = +150$ °С	20 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 1$ кОм:	
при $T_{п} = -60...+100$ °С	40 В
при $T_{п} = +125$ °С	27 В
при $T_{п} = +150$ °С	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Потенциал статического электричества	1000 В
Постоянный ток коллектора	400 мА
Импульсный ток коллектора, при $t_{п} = 10$ мкс, $Q = 2$	800 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора всех транзисторов:	
при $T = -60...+50$ °С	0,8 Вт
при $T = +125$ °С	0,2 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность всех транзисторов:	
при $T = -60...+50$ °С	3,2 Вт
при $T = +125$ °С	0,8 Вт

1. При повышении температуры среды от $+100$ до $+150$ °С $U_{КБ\text{ МАКС}}$, $U_{КЭ\text{ МАКС}}$, $U_{КЭР\text{ МАКС}}$ снижаются по линейному закону.

2. Допускается импульсное превышение напряжений до 70, 55 и 30 В соответственно при $t_{и} = 10$ мкс, $Q = 2$.

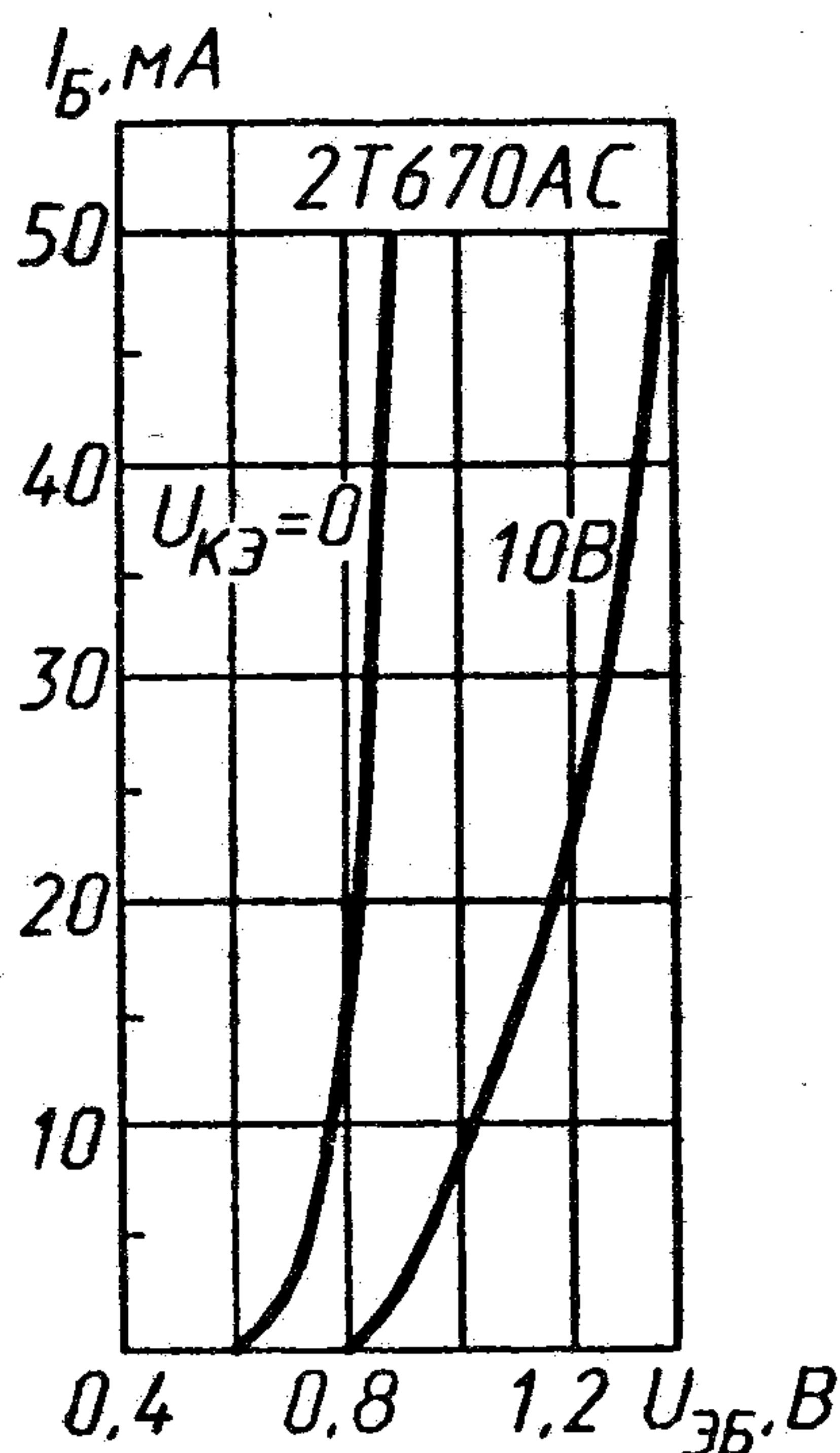
3. Допускается импульсное превышение напряжения до 70 В при $t_{и} = 10$ мкс, $Q = 2$, $R_{БЭ} = 1$ кОм, $T = -60...+100$ °С.

4. Допускается импульсно превышение $U_{ЭБ}$ при $I_{БЭ} \leq 20$ мА, $t_{и} = 10$ мкс, $Q = 2$.

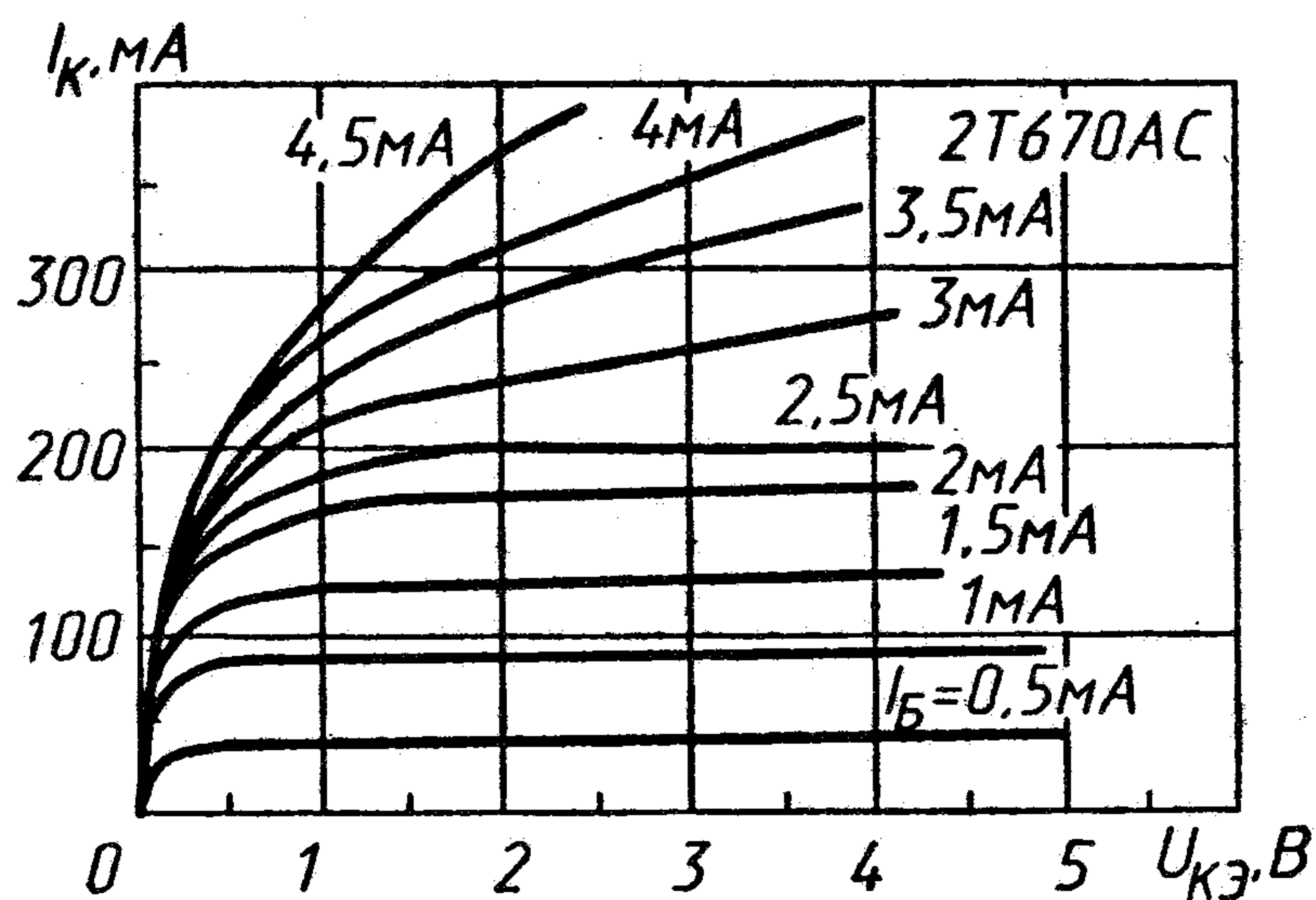
5. Постоянная и импульсная рассеиваемые мощности коллектора при температуре среды от +50 до +125 °С снижаются линейно.

Сборка пригодна для монтажа в аппаратуре методом пайки. Допустимое число перепаек выводов транзисторов при проведении монтажных операций — 1. Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода не менее 3 мм, температура припоя не выше +260 °С, время пайки не более 5 с.

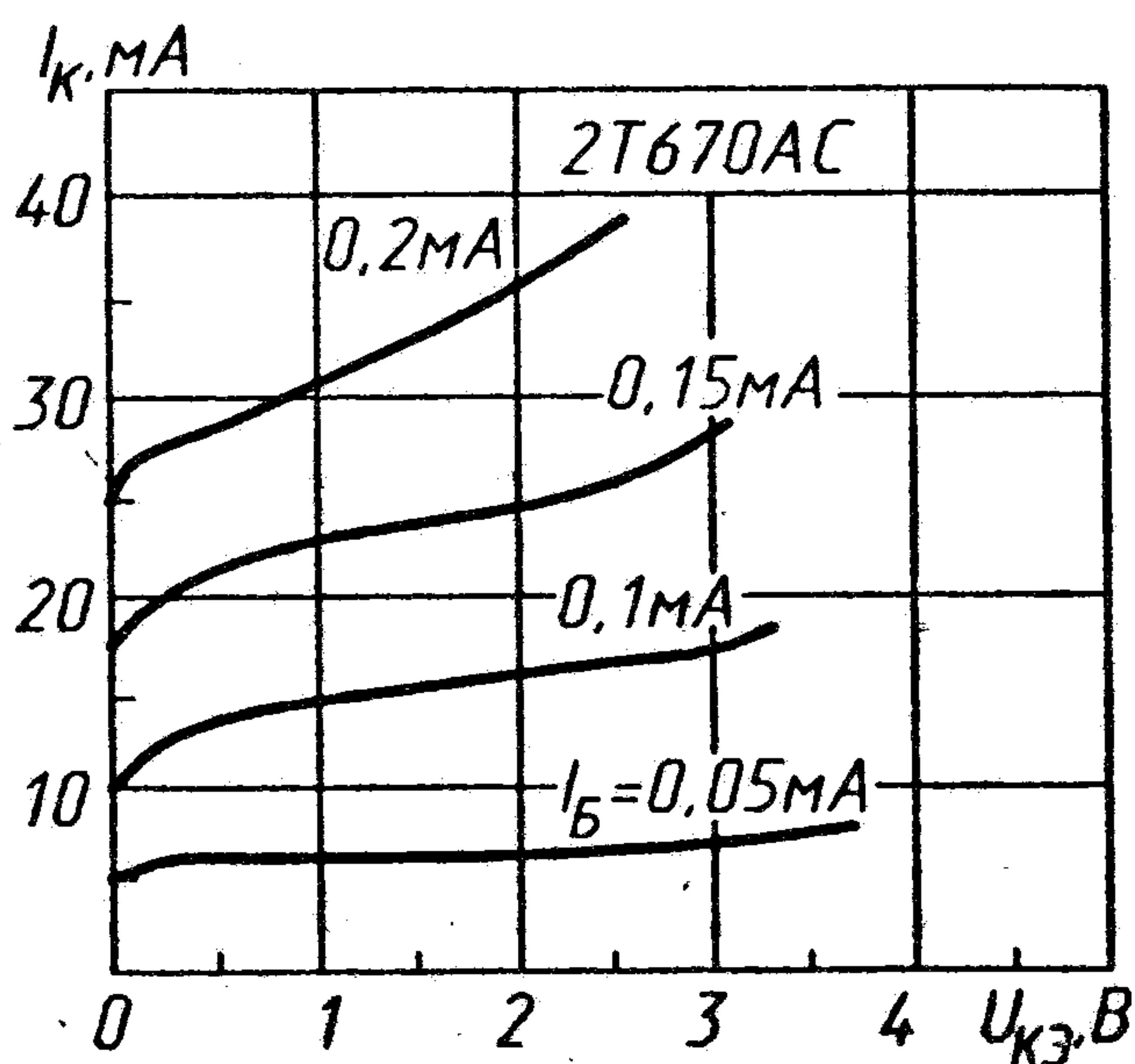
Рекомендуется при расчете схем учитывать возможность самовозбуждения.



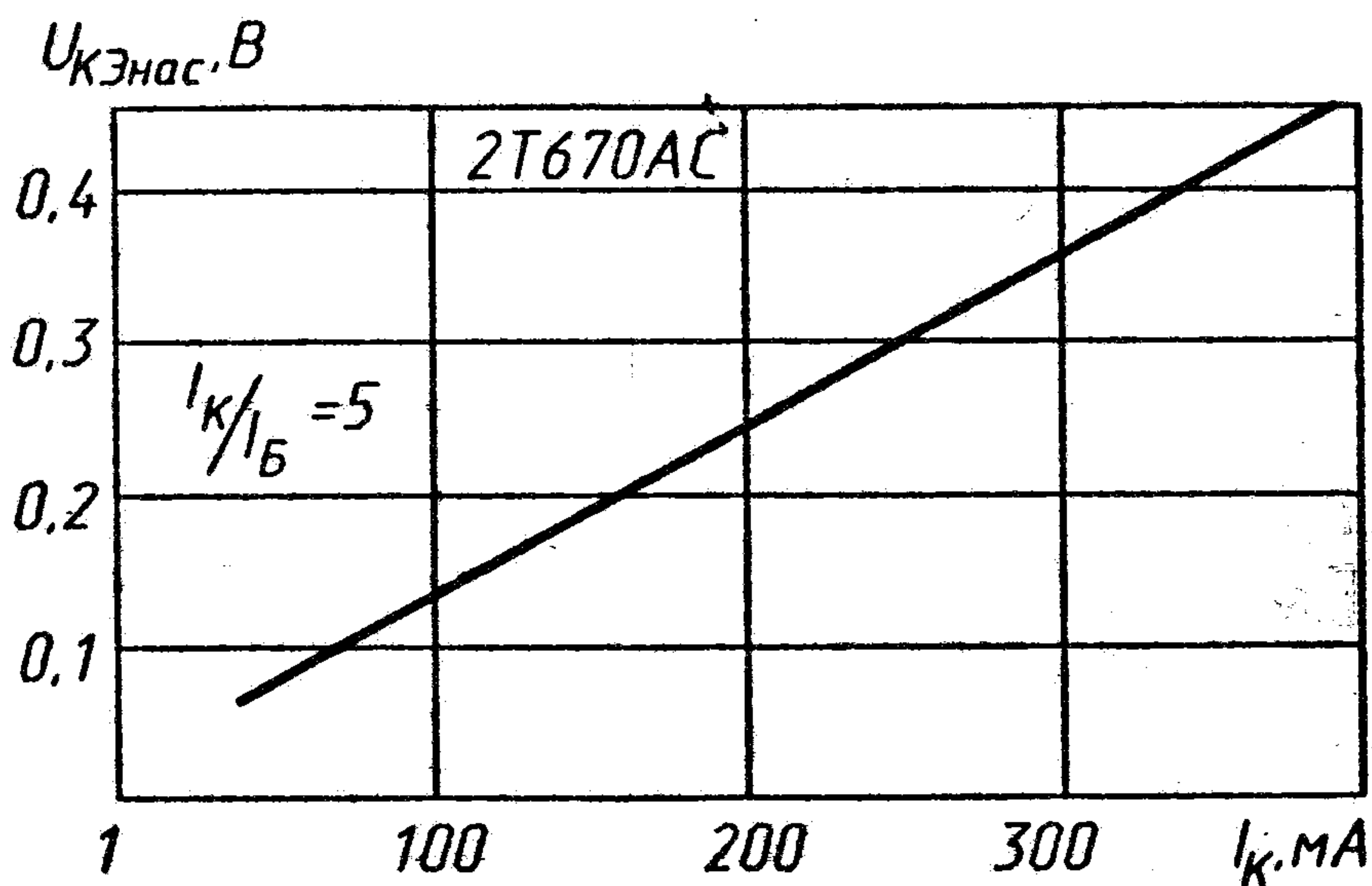
Входные характеристики



Выходные характеристики



Выходные характеристики



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора